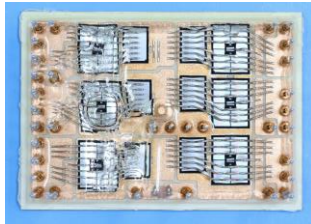
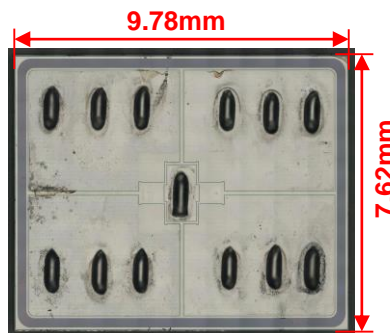


Infineon製 EasyPACK IGBTモジュール「FS100R12W2T7_B11」 (TRENCHSTOP IGBT7) 構造解析、プロセス解析オープンレポート

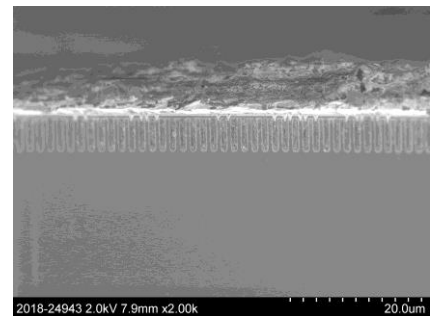
株式会社エルテックは、Infineon IGBT モジュール「FS100R12W2T7_B11」に搭載されている第7世代IGBT(IGBT7)の構造解析、プロセス・デバイス解析レポートをリリースしました。



モジュール写真



チップ写真



セル部断面SEM写真

製品の特徴

「FS100R12W2T7_B11」は、Infineon最新の第7世代IGBTを搭載 $V_{ces}=1200V$ 、 $I_c=100A$ 。

アプリケーションとしては、産業用ドライブ向けの製品になります。

IGBT7は、飽和電圧 $V_{ce, sat}$ を低減するための新しい高密度Micro Pattern Trench (MPT) 構造/レイアウトセルアレイを特徴としています。

前世代のIGBT6と比較するとIGBT7は、 $V_{ce}(sat)$ が1.85Vから1.5Vに約19%程度改善されています。

解析のポイント

- ・単位IGBTセルは7つのトレンチのグループによって形成され、これらのトレンチの接続について明らかにしています。
- ・製造プロセス技術について、最小加工寸法であるコンタクト開口部から有効なプロセス技術ノードを抽出しています。
- ・IGBT7とIGBT6トランジスタのオフ時コレクタリーク電流を比較。活性化エネルギーの有意差が確認されます。
- ・IGBTチップと並列接続されたFWDのブレーダウン電圧をそれぞれ測定しています。

レポート内容と価格

○IGBTモジュール、IGBT7構造解析レポート: 60万円 (税別)

1. IGBTモジュール、IGBT7構造解析レポート

【目次】		頁
1	表1: デバイスサマリー.....	3
1-1	解析結果まとめ.....	4-8
	表2: デバイス構造: Si IGBT	9
	表3: デバイス構造: レイヤー材料・膜厚	10
	表 4: 実装パッケージ構造概要	11
2	モジュール解析.....	12
2-1	外観観察.....	13-16
2-2	チップ写真.....	17-18
2-3	モジュール断面観察	19-44
3	Si IGBTチップ解析.....	45
3-1	平面構造解析(OM)	46-73
3-2	平面構造解析(SEM).....	74-86
3-3	断面構造解析(SEM).....	87-103
4	電気特性評価	104
4-1	測定箇所.....	105
4-2	Ic-Vce特性.....	106-107
4-3	オフ状態のコレクタ電流の比較.....	108
4-4	オフ状態のコレクタ耐圧電圧.....	109
5	付録 EDX分析結果.....	110-135
6	付録 追加解析リスト	136-137